



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

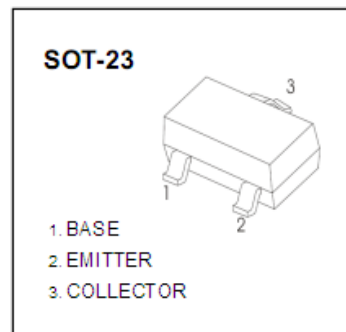
BC817-16/BC817-25/BC817-40(NPN)

特点/Features :

I_c 大, 电流增益大;

用途/Applications :

用于一般功率放大电路及开关, 与 BC807 互补。



极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CB0}	50	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	45	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EB0}	5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_c	0.5	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_c	0.3	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_c=10\mu A, I_E=0$	50			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_c=10mA, I_B=0$	45			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E=1\mu A, I_c=0$	5			V
集电极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=45V, I_E=0$			0.1	μA
发射极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=4V, I_c=0$			0.1	μA
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1V, I_c=100mA$	100		600	
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1V, I_c=500mA$	40			
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_c=500mA, I_B=50mA$			0.7	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_c=500mA, I_B=50mA$			1.2	V
基极-发射极压降	V_{BE}	$V_{CE}=1V, I_c=500mA$			1.2	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5V, I_c=10mA, f=100MHz$	100			MHz
输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$		10		pF

h_{FE} 分档/Classification of $h_{FE(1)}$

档位/Rank	16	25	40
范围/Range	100~250	160~400	250~600
印章/Marking	6A	6B	6C



典型特性曲线图/Typical Characteristics

